

(대외비 - 엄수)

문서 분류: SKH-FY25-Q3-CORP

작성 부서: 경영기획실, IR팀

작성일: 2025년 10월 28일

페이지: 1/3

제목: (주) SK 하이닉스 2025년 3분기 경영 실적 및 4분기 전망 (내부 보고서)

1. Executive Summary (경영 요약)

2025년 3분기는 AI 서버 시장의 지속적인 성장세에 힘입어 HBM(고대역폭 메모리) 제품군의 수요가 폭발적으로 증가했습니다. HBM 매출 비중이 전체 D램 매출의 50%를 상회하며 창사 이래 최대 분기 매출을 달성했습니다. 반면, 일반 소비자용 NAND Flash 시장은 여전히 회복이 더딘 상황입니다. 본 문서는 3분기 실적을 확정하고 4분기 주요 과제를 공유합니다.

2. 주요 재무 성과 (2025년 3분기, K-IFRS 연결 기준)

- 총 매출: 15조 4,000억 원 (전분기 대비 +18%, 전년 동기 대비 +120%)
- 영업 이익: 3조 1,000억 원 (영업이익률: 20.1%)
- 당기 순이익: 2조 5,500억 원
- 지역별 매출 현황:
 - APAC (아시아태평양): 7조 2,000억 원 (비중 46.8%)
 - Americas (미주): 5조 1,000억 원 (비중 33.1%)
 - EMEA (유럽 및 기타): 3조 1,000억 원 (비중 20.1%)

3. 핵심 제품별 수출 실적 (3분기 누계)

- 2025년 3분기 총 반도체 수출액: 980억 달러
- HBM (고대역폭 메모리)
 - 제품군: HBM3E (주력), HBM4 (A-Sample 공급 시작)
 - 총 수출액: 620억 달러
 - 주요 고객사: NVIDIA (65%), AMD (20%), Google (10%), 기타 (5%)
- DDR5 (서버용 DRAM)
 - 총 수출액: 250억 달러
 - 시장 점유율: 48% (업계 1위 유지)
- LPDDR6 (모바일 DRAM)
 - 총 수출액: 110억 달러 (신규 플래그십 스마트폰향 공급)

4. 생산 및 운영 현황 (Operations)

- 주요 팹(Fab) 가동 현황
 - Icheon M16 팹: 가동률 100%. (주력 제품: HBM3E 및 10나노급 5세대 DRAM)
 - Cheongju M15 팹: 가동률 85%. (주력 제품: UFS 4.0 NAND Flash)
 - Wuxi (중국) 팹: 가동률 90%. (레거시 공정 DRAM)
- 생산 수율 (Yield Rate)
 - HBM3E (TSV 공정): 88% (목표 90% 대비 소폭 미달, 개선 진행 중)

- 10나노급 5세대(1b) DDR5: 92% (안정화 단계 진입)
- 3분기 평균 웨이퍼 투입량: 380K/월 (DRAM 160K, NAND 220K)

5. 설비 투자(CAPEX) 및 수입 현황

- 3분기 CAPEX 집행액: 4조 5,000억 원 (연간 계획 15조 원의 30% 집행)
- 주요 장비 수입 (Import)
 - EUV 노광 장비 (ASML)
 - 3분기 도입 수량: 4대
 - 총 수입액: 18억 달러 (약 2조 4,000억 원)
 - 어드밴스드 패키징 본딩 장비 (Besi)
 - 3분기 도입 수량: 15대
 - 총 수입액: 4억 5,000만 달러
- 원자재 수입 (Raw Materials)
 - 고순도 실리콘 웨이퍼 (Shin-Etsu, SUMCO): 105억 달러
 - 고순도 헬륨 가스 (냉각용): 12억 달러
 - 극자외선(EUV)용 포토레지스트(PR): 8억 달러 (공급망 다변화 완료)

6. 재고 현황 (2025년 9월 30일 기준)

- HBM3E 재고: 450만 개 (재고 수준: 낮음, 공급 부족 지속)
- DDR5 (서버) 재고: 1,800만 개 (재고 수준: 안정)
- NAND Flash (UFS 4.0) 재고: 7,000만 개 (재고 수준: 높음, 출하 조절)
- 2025년 3분기 전체 재고 자산 규모: 13조 2,000억 원 (전분기 대비 5% 감소)
- 재고 건전성 평가: '양호' (NAND 제외)

7. R&D (연구개발) 동향

- HBM4 개발 현황: 12단 적층 A-Sample 테스트 통과, 2026년 양산 목표.
- CXL (Compute Express Link) 메모리: 2세대 CXL 메모리 모듈(CMM) 개발 완료, 고객사 인증 진행 중.
- 3D NAND: 400단 V-NAND 공정 개발 착수.
- 3분기 R&D 투자 비용: 1조 2,000억 원 (매출 대비 7.8%)
- 3분기 신규 특허 출원 건수: 310건 (국내 180, 해외 130)

8. 인적 자원 (HR) 현황

- 글로벌 총 임직원 수: 38,500명 (국내 29,000명, 해외 9,500명)
- 3분기 신규 채용 인원: 520명 (R&D 250명, 공정/설비 200명, 기타 70명)
- 3분기 필수 안전 교육 이수율: 99.8%
- 핵심 인재 이직률 (HBM 부문): 0.8% (안정적 관리)

9. 4분기 전망 및 주요 리스크

- 4분기 예상 매출: 17조 원 (HBM 수요 지속 및 NAND 시장 소폭 회복 기대)
- 4분기 예상 HBM 매출: 8조 5,000억 원

- 주요 리스크:

- 1) 글로벌 경기 침체에 따른 IT 기기 수요 둔화 가능성
- 2) HBM 후공정(패키징) 병목 현상 (CapEx 확대에 대응 중)
- 3) 원자재(헬륨) 가격 변동성